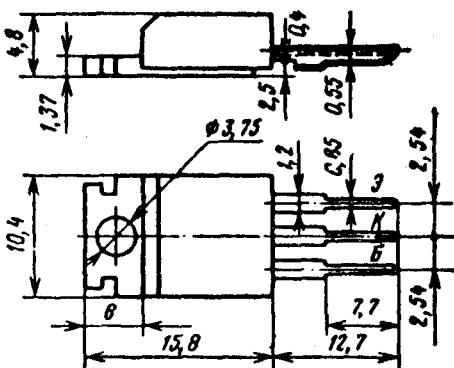


# KT829 (А, Б, В, Г)

## KT829(А-Г)

Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры  $n-p-n$  составные усиительные. Предназначены для применения в усилителях низкой частоты, переключающих устройствах. Корпус пластмассовый с жесткими выводами.

Масса транзистора не более 2 г.



### Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{KE}=3$  В,  $I_K=3$  А, не менее:

$T_{\pi} = +25 \dots +85^{\circ}\text{C}$	750
$T_{\pi} = -40^{\circ}\text{C}$	100

Модуль коэффициента передачи тока при  $U_{KE}=3$  В,  $I_K=3$  А,  $f=10$  МГц, не менее . . . . .

0,4

Границочное напряжение при  $I_K=100$  мА, не менее:

KT829A . . . . .	100 В
KT829Б . . . . .	80 В
KT829В . . . . .	60 В
KT829Г . . . . .	45 В

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при  $I_K=3,5$  А,  $I_B=14$  мА, не более . . . . .

2 В

Напряжение насыщения база — эмиттер при  $I_K=3,5$  А,  $I_B=14$  мА, не более . . . . .

2,5 В

Обратный ток коллектор — эмиттер при  $U_{KEB}=U_{KEB,\max}$ ,  $R_{b3} \leq 1$  кОм, не более:

$T_{\pi} = +25 \text{ и } -40^{\circ}\text{C}$	1,5 мА
$T_{\pi} = +85^{\circ}\text{C}$	3 мА

Обратный ток эмиттера при  $U_{BE}=5$  В, не более . . . . .

2 мА

Емкость коллекторного перехода при  $U_{KE}=U_{KE,\max}$ , не более . . . . .

120 пФ

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при  $R_{b3} \leq 1$  кОм, постоянное напряжение коллектор — база.

KT829А . . . . .	100 В
KT829Б . . . . .	80 В
KT829В . . . . .	60 В
KT829Г . . . . .	45 В

Постоянное напряжение база — эмиттер . . . . .

5 В

Постоянный ток коллектора . . . . .

8 А

Импульсный ток коллектора при  $t_u \leq 500$  мкс,  $Q \geq 10$  . . . . .

12 А

Постоянный ток базы . . . . .

0,2 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при

60 Вт

$T_{\pi} = -40 \dots +25^{\circ}\text{C}$	60 Вт
$T_{\pi} = +85^{\circ}\text{C}$	2,08° С/Вт

Тепловое сопротивление переход — корпус . . . . .

+150° С

Температура  $p-n$  перехода . . . . .

-40° С.  $T_{\pi} =$

Температура окружающей среды . . . . .

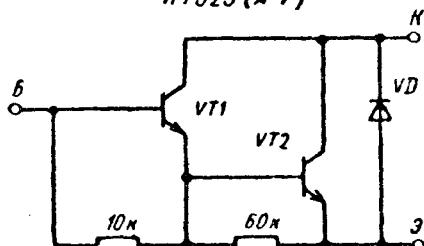
= +85° С

<sup>1</sup> При  $T_{\pi} = +25, +85^{\circ}\text{C}$   $P_H \max$  рассчитывается по формуле

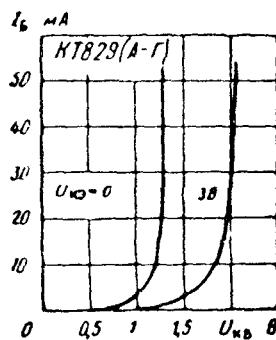
$$P_{H \max} \text{ Вт} = (150 - T_{\pi}) / 2,08$$

Пайка выводов транзисторов допускается не ближе 5 мм от корпуса, при этом температура корпуса не должна превышать +85° С

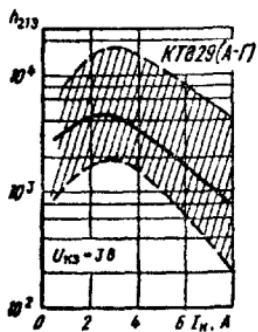
### KT829(А-Г)



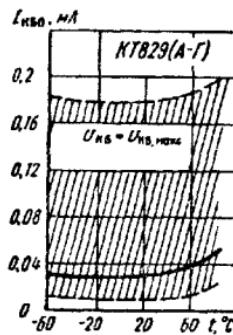
Электрическая схема транзистора



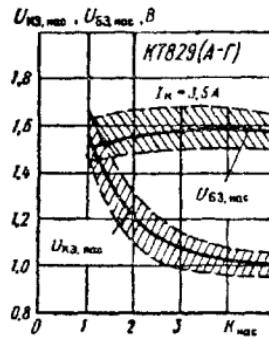
Входные характеристики



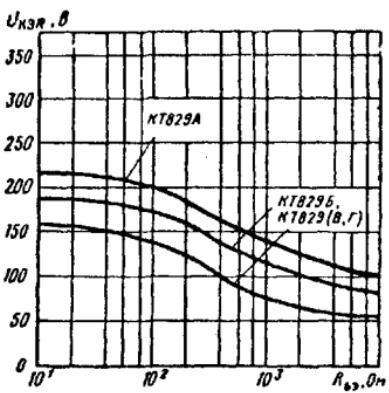
Зона возможных положений зависимостей статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



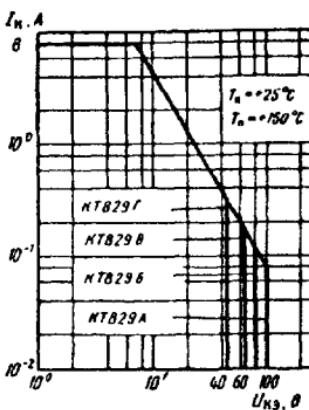
Зона возможных положений зависимости обратного тока коллектора от температуры



Зона возможных положений зависимостей напряжений насыщения коллектор — эмиттер и база — эмиттер от коэффициента насыщения



Зависимости постоянного напряжения коллектор — эмиттер от сопротивления база — эмиттер



Области максимальных режимов